阳极杆箍缩二极管产生 X 射线能谱的模拟计算*

张鹏飞¹⁾²⁾苏兆锋²⁾孙剑锋²⁾杨海亮²⁾李永东^{1)†}高屹²⁾
孙 江²⁾ 王洪广¹⁾尹佳辉²⁾梁天学²⁾孙凤举²⁾王志国²⁾
1)(西安交通大学电子物理与器件教育部重点实验室,西安 710049)
2)(西北核技术研究所,西安 710024)
(2010年8月25日收到;2011年1月25日收到修改稿)

采用粒子模拟,得到了阳极杆箍缩二极管阳极钨针上电子的空间分布和入射角分布,分析二极管工作状态得 到了电子的能量分布.在此基础上建立阳极杆箍缩二极管的蒙特卡罗模型,模拟得到了阳极杆箍缩二极管的辐射 能谱和X射线的平均能量,并与实验结果进行了比较.结果表明:09006炮光子平均能量为0.441 MeV,计算该能谱 射线经过不同厚度铅衰减片后的剂量衰减情况,与叠片法 PIN 探测器所测的实验数据基本一致.

关键词:阳极杆箍缩二极管,粒子模拟,蒙特卡罗方法,X射线能谱 PACS:02.60.Cb,41.50.+h,52.59.Mv

1. 引 言

阳极杆箍缩二极管(rod-pinch diode, RPD)能 够稳定聚焦、可产生高剂量率、小焦斑的高能脉冲 X 射线,具有广泛的应用前景^[1-3]. RPD 所产生 X 射 线的能谱是表征其辐射特性的重要参数,文献[4] 通过焦斑尺寸和二极管工作状态来提取参数建立 蒙特卡罗模型,数值模拟得到 X 射线能谱.本文通 过分析二极管电压、电流波形,得到轰击阳极钨针 电子的能量分布;采用 PIC(particle-in-cell, PIC)方 法分析电子在阳极钨针上的空间分布和入射角分 布情况.在此基础上,建立蒙特卡罗模型,模拟得到 RPD 二极管的射线能谱.

2. 基本物理分析

阳极杆箍缩二极管的常见结构是利用一个薄 环形阴极环绕着一根小直径阳极杆,阳极杆向外延 伸并逐渐变细,超出阴极平面一段距离.当馈入脉 冲电压波时,RPD的工作过程大致分为三个阶段: 空间电荷限制阶段(space-charge limited, SCL)、弱 箍缩阶段(weakly pinched, WP)和磁绝缘强箍缩阶 段 (magnetically limited and strongly pinched, ML)^[5]. 不同阶段电流发展过程如下:

1)开始时,二极管工作电压较低,电流较小,阴 极发射电子沿径向运动,电子的运动基本上由电场 力决定,属于空间电荷限制阶段,产生少量 X 射线;

2)随着电压和电流的增大,电子的运动受到磁场力的影响越来越大,运动轨迹偏离原来的轨道发生偏转,属于弱箍缩阶段,产生少量X射线;

3)当电压和电流足够大时,空间电荷受到的力中自磁场力开始占主导地位,带电粒子不再服从空间电荷限制流模式,电子发生磁绝缘并沿阳极杆运动,聚焦轰击阳极杆末端,属于磁绝缘强箍缩阶段,产生很强的轫致辐射X射线.

阳极杆箍缩二极管三阶段模型的电子分布图 像如图1所示.

3. 实验描述

西北核技术研究所已成功研制感应电压叠加器(inductive voltage adder, IVA)驱动 RPD 型脉冲 X 射线源^[6],其结构如图 2 所示,主要由低电感 Marx 发生器、水介质脉冲形成线、平板传输线、IVA 感应 腔、真空绝缘传输线和阳极杆箍缩二极管构成.

^{*}国家自然科学基金(批准号10775112,50807045)资助的课题.

[†]通讯联系人. E-mail: leyond@mail. xjtu. edu. cn

^{©2011} 中国物理学会 Chinese Physical Society



图 1 RPD 不同阶段电子束空间分布状态 (a)空间电荷限制阶段;(b)弱箍缩阶段;(c)磁限制阶段



图 2 IVA/RPD 实验平台结构示意图

在该装置上进行的 09006 炮实验, RPD 阴极为 3.2 mm 厚环形石墨圆盘,圆盘外半径 74 mm,孔半径 8 mm,阳极采用直径 1.2 mm 钨针,钨针末端 10 mm 均匀磨尖,阳极杆伸出圆盘表面 14 mm. 二极管区域 电感值为 192 nH,对实验测得的二极管电压进行电 感修正.图3(a)中灰色曲线是电感修正后的电压波 形,黑色曲线是09006炮实验中二极管位置的电流波 形.图3(b)是该炮实验二极管阻抗曲线.由图知:二 极管电压峰值为2.0 MV,半宽75 ns,电流峰值44 kA,半宽76 ns,二极管稳定工作阻抗约40Ω.



图 3 (a) IVA/RPD 实验平台 09006 炮实验二极管电压电流波形;(b) 阻抗曲线

IVA/RPD 实验平台产生的高能 X 射线,采用叠 片法进行测量.实验中采用 7 个独立的 PIN 探测器 组成阵列^[7],探测器准直孔前铅衰减片厚度分别为 0、4.4,8.7,12.0,16.0,20.0 和 24.0 mm.实验测得 09006 炮 X 射线波形如图 4 所示.由图可知,随铅滤 片厚度增加,射线强度减弱.这种现象是由于铅衰 减片对光子的屏蔽作用造成的,衰减片越厚,到达 PIN 探测器的光子越少.



图4 叠片法测量 09006 炮获得不同衰减的 X 射线

4. 数值模拟

4.1. RPD 的 PIC 模拟

使用西安交通大学和西北核技术研究所联合 开发的 PIC 模拟软件 UNIPIC 2D^[8]对 RPD 进行模 拟. 对应于 09006 炮实验, RPD 二极管计算模型如 图 5 所示. 结构参数为:石墨阴极厚 3.2 mm, 阴极盘 外半径 74 mm, 孔半径 8 mm, 电子发射阈值为 230 kV/cm; 阳极钨针直径 1.2 mm, 伸出阴极盘前表面 (接近针尖的表面)14 mm. 输入电压对应于图 3(a) 所示的电压波形. 设定阳极质子电流为 18 kA, 质子 发射区域为距离针尖 22 mm 范围内^[3,9–11].

模拟得到不同阶段电子的相空间分布如图 1 所示,到达阳极杆上的电子分布如图 6 所示,对应图 5 所示的 PIC 模型,横轴表示钨针的轴向位置,0 点表示针尖处,纵坐标表示箍缩电子在阳极钨针上的相对分布.结果表明,针尖位置电子最多,97% 的电子分布在距离针尖 14 mm 的范围内(阴极圆盘下游区域).到达阳极钨阵的电子受到电场力和磁场力的



图 5 09006 炮 RPD 实验的 PIC 模型

共同作用,运动轨迹十分复杂,统计电子到达钨阵 表面时的角度分布情况,如图7所示.



图 6 电子到达阳极钨针时的轴向分布



图 7 电子到达阳极钨阵时的角分布

4.2. 电子能谱的近似求解

电流对时间的积分即为电荷,电荷大小表征了 电子数目的多少.对于 RPD,通过二极管的电压、电 流信号,然后利用电压电流在时间上的对应关系可以换算得到电子能谱函数 g(E).计算公式为

$$g_{(E)} = \sum_{d} I_d(U) \Delta t_d / e, \qquad (1)$$

其中 *E* 为电子能量, $g_{(E)}$ 表示能量为 *E* 的电子数 目, *E* = eU; e 为一个电子的电荷值; *U* 为电压; I_d 表示该分段时间内的电流值; Δt 表示电压电流曲线 上的时间间隔,取较小的 Δt , 可认为在该时间段内 电压恒定.

分析如图 3 所示 09006 炮的二极管电压、电流数据. 电压间隔取 0.1 MV,得到电子能量分布如图 8 所示. 由图 8 可知电子在较高能量(1.3—2.0 MeV 附近)时电子数目较多,1.3—2.0 MeV 范围的电子 占总数的 68%.分析认为是由于电压较高时,电流 处于最大值附近,电流对时间的积分值相对较大. 所以表现为能量较高(1.3—2.0 MeV 附近)的电子 较多.



图 8 09006 炮电子能量分布

4.3. RPD 的蒙特卡罗模型

对应于 RPD 工作过程,建立电子轰击钨针产生 X 射线的蒙特卡罗模型,如图 9 所示.电子源的主要 参数是空间分布函数 $f_{(z)}$ 、电子的入射角和能量分 布函数 $g_{(\varepsilon)}$. 空间分布函数 $f_{(z)}$ 如图 6 所示,电子入 射角如图 7 所示,电子的能量分布函数 $g_{(\varepsilon)}$ 如图 8 所示.

由于97%的电子分布在距离针尖14 mm的范围内,所以在蒙特卡罗模型中取钨针长度为14 mm, 其末端10 mm区域为均匀锥状.对应于实验中的屏蔽条件,在针尖正前方分别放置有机玻璃板(20 mm厚)、铜网(2 mm厚)和胶木片(10 mm厚),忽略4.2 m空气的作用.计算得到高能脉冲 X 射线的能谱如图10 所示,图中采用对数坐标系,横轴为光子



图 9 RPD 蒙特卡罗模型示意图

的能量,纵轴表示单个电子轰击钨针时, 轫致辐射 产生的不同能量光子的相对个数.结果表明:09006 炮实验中光子平均能量为 0.441 MeV.



图 10 高能脉冲 X 射线能谱

对应于实验中测量 X 射线的叠片法,采用蒙特 卡罗方法建立数值模型.射线源能量分布为图 10 所 示的模拟结果,假设射线垂直入射层叠放置的衰减 片(1 mm 厚,铅)和剂量片(0.3 mm 厚,硅).模拟得 到射线经过不同厚度铅衰减片后的相对剂量衰减 如图 11 中虚线所示.对图 4 中采用叠片法测量的脉



图 11 X 射线经过不同厚度铅衰减片后的剂量变化

冲 X 射线波形进行积分,获得 09006 炮脉冲 X 射线 经过不同衰减后的相对剂量值,如图 11 中实线所示.对比相对剂量衰减情况,实验和模拟结果基本一致.

5. 结 论

采用粒子模拟得到了电子在阳极杆上的空间 分布,结果表明97%的电子分布在距离针尖14 mm 的范围内;分析二极管工作状态得到电子的能谱分 布,表明1.3—2.0 MeV 范围内的电子占总电子数 的68%.在获得电子能量和空间分布的基础上建立 RPD 的蒙特卡罗模型,获得了二极管辐射能谱.模 拟结果表明:09006 炮光子平均能量为0.441 MeV. 计算该能谱射线经过不同厚度铅衰减片后的剂量 衰减情况,对比叠片法 PIN 探测器所测的实验结果, 模拟结果与实验结果基本一致.

- [1] Cooperstein G, Boller J R, Commisso R J, Hinshelwood D H, Mosher D, Ottinger P F, Schumer J C, Stephanakia S J, Swanekamp S B, Weber B V, Young F C 2001 Phys. Plasmas 8 4618
- [2] Young F C, Commisso R J, Allen R J, Mosher D, Swanekamp S B, Cooperstein G, Bayol F, Charre P, Garrigues A, GONZALES C, Pompier F, Vezinet R 2002 Phys. Plasmas 9 4815
- [3] Commisso R J, Cooperstein G, Hinshelwood D H, Mosher D, Ottinger P F, Stephanakia S J, Swanekamp S B, Weber B V, Young F C 2002 *IEEE Trans. Plasma Sci.* 30 338
- [4] Weber B V, Allen R J, Commisso R J, Cooperstein G, Hinshelwood D D, Mosher D, Murphy D P, Ottinger P F, Phipps D G, Schumer J W, Stephanakis S J, Swanekamp S B, Pope S, Threadgold J, Biddle L, Clough S, Jones A, Sinclair M, Swatton D, Carden T, Oliver B V 2007 Proceeding of Pulsed Power and Plasma Science Coference, Albuquerque, New Mexico. p591
- [5] Ma C G, Deng J J, Xie M 2007 High Power and Laser and Particle Beams 19 348(in Chinese)[马成刚、邓建军、谢 敏 2007 强激光与粒子束 19 348]
- [6] Sun F J, Qiu A C, Yang H L, Zeng J T, Gai T Y, Liang T X, Ying J H, Sun J F, Cong P T, Huang J J, Su Z F, Gao Y, Liu

Z G, Jiang X F, Li J Y, Zhang Z, Song G Z, Pei M J, Niu S L 2010 *High Power and Laser and Particle Beams* **22** 936 (in Chinese)[孙凤举、邱爱慈、杨海亮、曾江涛、盖同阳、梁天学、 尹佳辉、孙剑锋、丛培天、黄建军、苏兆锋、高 屹、姜晓锋、李 静雅、张 众、宋顾周、裴明敬、牛胜利 2010 强激光与粒子束 **22** 936]

- [7] Su Z F, Yang H L, Qiu A C, Cong P T, Wang L P, Lei T S, Han J J 2010 Acta Phys. Sin. 59 7729(in Chinese)[苏兆锋、杨 海亮、邱爱慈、孙剑锋、丛培天、王亮平、雷天时、韩娟娟 2010 物理学报 59 7729]
- [8] Li Y D, Wang H G, Liu C L, Zhang D H, Wang J G, Wang Y 2009 High Power Laser and Particle Beams 21 1866 (in Chinese)[李永东、王洪广、刘纯亮、张殿辉、王建国、王 玥 2009 强激光与粒子束 21 1866]
- [9] Chen L, Jiang W, Xie W P, Deng J J 2007 High Power and Laser and Particle Beams 19 1747 (in Chinese) [陈 林、姜 巍、谢卫平、邓建军 2007 强激光与粒子束 19 1747]
- [10] Gao Y, Qiu A C, Zhang Z, Zhang P F, Wang Z, Yang H L 2010 Phys. Plasmas 17 073108
- [11] Qan L, Zhang Y M, Tu J, Chen Z H, Lai D G, Fan Y J, Shao H 2006 High Power and Laser and Particle Beams 18 317 (in Chinese) [全 林、张永民、屠 荆、陈志华、来定国、樊亚军、 邵 浩 2006 强激光与粒子束 18 317]

Numerical investigation of x-ray energy spectrum of rod-pinch diode*

Zhang Peng-Fei¹⁾²⁾ Su Zhao-Feng¹⁾ Sun Jian-Feng²⁾ Yang Hai-Liang¹⁾ Li Yong-Dong^{1)†} Gao Yi²⁾

Sun Jiang² Wang Hong-Guang¹ Yin Jia-Hui² Liang Tian-Xue² Sun Feng-Ju² Wang Zhi-Guo²

1) (Key Laboratory for Physical Electronics and Devices of the Ministry of Education, Xi' an Jiaotong University, Xi' an 710049, China)

 $2\,)\,(\mathit{Northwest\ Institute\ of\ Nuclear\ Technology\,,\ Xi'an}\quad 710024\,,\ China\,)$

(Received 25 August 2010; revised manuscript received 25 January 2011)

Abstract

By particle-in-cell (PIC) simulation and theoretically analysis, electron spatial distribution and energy distribution in the rod surface of rod-pinch diode (RPD) are obtained separately, as input parameters for Monte Carlo simulation of photon energy spectrum of X-ray emitted from RPD. The Monte Carlo simulation results show that the average photon energy of shot 09006 is 0.441 MeV. Taking account of Pb attenuator, the simulation results accord with experiment data detected by PIN detectors array.

Keywords: rod-pinch diode, particle-in-cell, Monte Carlo, energy spectrum **PACS**: 02.60. Cb, 41.50.+h, 52.59. Mv

^{*} Project supported by the National Nathral Science Foundation of China (Grant Nos. 10775112, 50807045).

[†] Corresponding author. E-mail: leyond@mail.xjtu.edu.cn